

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Classification No  
PCT/DE 03/02352

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> IPC 7 H01L21/20 H01L21/314 H01L21/762 H01L29/786 H01L21/28		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, INSPEC		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 810 924 A (MEYERSON BERNARD STEELE ET AL) 22 September 1998 (1998-09-22) column 15, line 12-24	1-20
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 13, 30 November 1999 (1999-11-30) & JP 11 233440 A (TOSHIBA CORP), 27 August 1999 (1999-08-27) abstract	1-20
-/-		
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search  18 December 2003		Date of mailing of the international search report  07/01/2004
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer  Wolff, G

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 International Publication No  
 PCT/DE 03/02352

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>TEZUKA T ET AL: "HIGH-PERFORMANCE STRAINED SI-ON-INSULATOR MOSFETS BY NOVEL FABRICATION PROCESSES UTILIZING GE-CONDENSATION TECHNIQUE"</p> <p>2002 SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY. DIGEST OF TECHNICAL PAPERS. HONOLULU, JUNE 11 - 13, 2002, SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, NEW YORK, NY: IEEE, US, 11 June 2002 (2002-06-11), pages 96-97, XP001109835</p> <p>ISBN: 0-7803-7312-X</p> <p>Abstract, Introduction, Device fabrication</p>	1-20
A	<p>TEZUKA T ET AL: "Fabrication of a strained is on sub-10-nm-thick SiGe-on-insulator virtual substrate"</p> <p>MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 89, no. 1-3, 14 February 2002 (2002-02-14), pages 360-363, XP004334431</p> <p>ISSN: 0921-5107</p> <p>Abstract and 1. Introduction</p>	1-20
A	<p>EP 1 120 818 A (ASAHI CHEMICAL IND)</p> <p>1 August 2001 (2001-08-01)</p> <p>paragraph '0078!; claims 1,8</p>	1-20
A	<p>US 5 569 538 A (CHO CHIH-CHEN)</p> <p>29 October 1996 (1996-10-29)</p> <p>claims; figure 1</p>	1-20
A	<p>ZOGG H: "STRAIN RELIEF IN EPITAXIAL FLUORIDE BUFFER LAYERS FOR SEMICONDUCTORHETEROEPITAXY"</p> <p>APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 49, no. 15, 13 October 1986 (1986-10-13), pages 933-935, XP000816962</p> <p>ISSN: 0003-6951</p> <p>page 933, left-hand column, last paragraph -right-hand column, paragraph 1</p>	1-20

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 93/02352

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5810924	A	22-09-1998	US 5659187 A BR 9201914 A CA 2062134 A1 EP 0515859 A1 JP 2582506 B2 JP 5129201 A	19-08-1997 12-01-1993 01-12-1992 02-12-1992 19-02-1997 25-05-1993
JP 11233440	A	27-08-1999	NONE	
EP 1120818	A	01-08-2001	AU 5760199 A CA 2345122 A1 EP 1120818 A1 CN 1319252 T WO 0019500 A1 TW 474012 B	17-04-2000 06-04-2000 01-08-2001 24-10-2001 06-04-2000 21-01-2002
US 5569538	A	29-10-1996	US 5453399 A	26-09-1995

# INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Internationales Einzelzeichen

PCT/DE 03/02352

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H01L21/20 H01L21/314 H01L21/762 H01L29/786 H01L21/28

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EP0-Internal, INSPEC

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 810 924 A (MEYERSON BERNARD STEELE ET AL) 22. September 1998 (1998-09-22) Spalte 15, Zeile 12-24	1-20
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 13, 30. November 1999 (1999-11-30) & JP 11 233440 A (TOSHIBA CORP), 27. August 1999 (1999-08-27) Zusammenfassung	1-20



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*I\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

18. Dezember 2003

Absenddatum des Internationalen Recherchenberichts

07/01/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Wolff, G

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>TEZUKA T ET AL: "HIGH-PERFORMANCE STRAINED SI-ON-INSULATOR MOSFETS BY NOVEL FABRICATION PROCESSES UTILIZING GE-CONDENSATION TECHNIQUE"</p> <p>2002 SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY. DIGEST OF TECHNICAL PAPERS. HONOLULU, JUNE 11 - 13, 2002, SYMPOSIUM ON VLSI TECHNOLOGY, NEW YORK, NY: IEEE, US,</p> <p>11. Juni 2002 (2002-06-11), Seiten 96-97, XP001109835</p> <p>ISBN: 0-7803-7312-X</p> <p>Abstract, Introduction, Device fabrication</p>	1-20
A	<p>TEZUKA T ET AL: "Fabrication of a strained Si on sub-10-nm-thick SiGe-on-insulator virtual substrate"</p> <p>MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH,</p> <p>Bd. 89, Nr. 1-3,</p> <p>14. Februar 2002 (2002-02-14), Seiten 360-363, XP004334431</p> <p>ISSN: 0921-5107</p> <p>Abstract and 1. Introduction</p>	1-20
A	<p>EP 1 120 818 A (ASAHI CHEMICAL IND)</p> <p>1. August 2001 (2001-08-01)</p> <p>Absatz '0078!; Ansprüche 1,8</p>	1-20
A	<p>US 5 569 538 A (CHO CHIH-CHEN)</p> <p>29. Oktober 1996 (1996-10-29)</p> <p>Ansprüche; Abbildung 1</p>	1-20
A	<p>ZOGG H: "STRAIN RELIEF IN EPITAXIAL FLUORIDE BUFFER LAYERS FOR SEMICONDUCTOR HETEROEPITAXY"</p> <p>APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US,</p> <p>Bd. 49, Nr. 15,</p> <p>13. Oktober 1986 (1986-10-13), Seiten 933-935, XP000816962</p> <p>ISSN: 0003-6951</p> <p>Seite 933, linke Spalte, letzter Absatz -rechte Spalte, Absatz 1</p>	1-20

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu einer Patentfamilie gehören

Internationaler Kennzeichen

PCT/DE 98/02352

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5810924	A	22-09-1998	US	5659187 A	19-08-1997
			BR	9201914 A	12-01-1993
			CA	2062134 A1	01-12-1992
			EP	0515859 A1	02-12-1992
			JP	2582506 B2	19-02-1997
			JP	5129201 A	25-05-1993
JP 11233440	A	27-08-1999	KEINE		
EP 1120818	A	01-08-2001	AU	5760199 A	17-04-2000
			CA	2345122 A1	06-04-2000
			EP	1120818 A1	01-08-2001
			CN	1319252 T	24-10-2001
			WO	0019500 A1	06-04-2000
			TW	474012 B	21-01-2002
US 5569538	A	29-10-1996	US	5453399 A	26-09-1995